

2Т325В

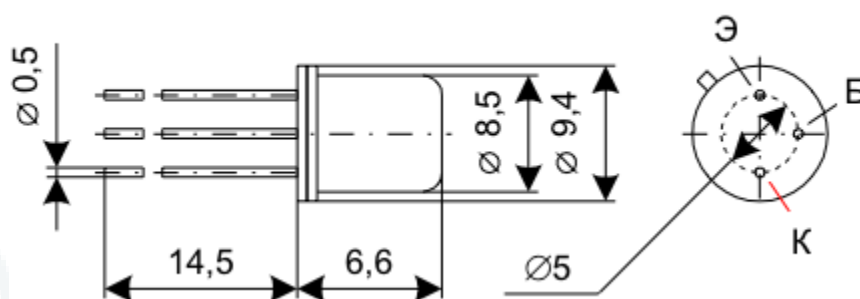
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Тип приборов указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,2 г.

Тип корпуса: КТ-2-3.

Технические условия: СБ0.336.023 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора 2Т325В:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с общим эмиттером: 160...400;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схемы с ОЭ: не менее 1000 МГц;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 15$ В: не более 0,5 мкА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 2,5 пФ;
- $U_{кб\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 15 В;
- $U_{кэг\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 3$ кОм: 15 В;
- $U_{эбо\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 4 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 60 мА;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 225 мВт.